



<p>(51) 国際特許分類7 H01J 37/302, 37/317</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/26938</p> <p>(43) 国際公開日 2000年5月11日(11.05.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/IP99/06038</p> <p>(22) 国際出願日 1999年10月29日(29.10.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/310658 1998年10月30日(30.10.98) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド (APPLIED MATERIALS INC.)[US/US] 95054 カルフォルニア サンタ クララ パウアーズアベニュー 3050 California, (US)</p> <p>(72) 発明者; および (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ) 伊藤裕之(ITO, Hiroyuki)[JP/JP] 阿世知大(ASECHI, Hiroshi)[JP/JP] 〒286-8516 千葉県成田市新泉14-3 アプライド マテリアルズ ジャパン株式会社内 Chiba, (JP)</p> <p>(74) 代理人 弁理士 長谷川芳樹, 外(HASEGAWA, Yoshiki et al.) 〒104-0061 東京都中央区銀座二丁目6番12号 大倉本館 創英国際特許法律事務所 Tokyo, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 KR, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54) Title: <u>APPARATUS FOR ION IMPLANTATION</u></p>		
<p>(54) 発明の名称 イオン注入装置</p>		
<p>(57) Abstract</p> <p>An apparatus for ion implantation comprises an ion source (18) for producing ions; an ion implantation head (14) for implanting a substrate (92) with ions generated by the ion source (18); a charge generator (62) for producing particles charged oppositely to the ions; a beam guide (24) including an entrance (24a) through which ions are received from the ion source (18), an exit (24b) through which ions are sent to the ion implantation head (14), a guide tube (24c) extending from the entrance (24a) to the exit (24b) and a section (80) having an opening (82) in the inside (24d) of the guide tube (24c) for introducing charged particles from the charge generator (62) into the guide tube (24c); and a shield (84) disposed between the opening (82) in the section (80) and the exit (24b) in the guide tube (24c). The shield (84) includes a shield surface (84a) for stopping polluted particles from reaching the wafer.</p>		